

Silicon Diode

BAY23

High Voltage Diode

1000V / 50mA

DATASHEET

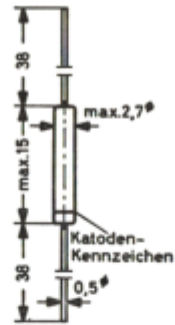
OEM – ITT Intermetall

Source: ITT Intermetall Databook 73/74

BAY 23 ... BAY 26

Diffundierte Silizium-Hochspannungs-Flächendiode

Glasgehäuse DO-7 lang
Gewicht ca. 0,3 g
Maße in mm



Grenzwerte

Typ	Sperrspannung U_R V
BAY 23	1000
BAY 24	1500
BAY 25	2000
BAY 26	3000

Stoßspitzenspannung bei $t < 1$ ms

BAY 23	U_{RSM}	1500	V
BAY 24	U_{RSM}	2250	V
BAY 25	U_{RSM}	3000	V
BAY 26	U_{RSM}	4500	V

Richtstrom in Einwegschaltung
mit R -Last, bei $T_U = 45$ °C

I_0 50 mA

Verlustleistung bei $T_U = 45$ °C

P_{tot} 250 mW

Sperrschichttemperatur

T_j 150 °C

Kennwerte bei $T_j = 25$ °C

Durchlaßspannung bei $I_F = 80$ mA

U_F <3 V

Sperrstrom

BAY 23 bei $U_R = 1000$ V

I_R <1 μ A

BAY 24 bei $U_R = 1500$ V

I_R <1 μ A

BAY 25 bei $U_R = 2000$ V

I_R <1 μ A

BAY 26 bei $U_R = 3000$ V

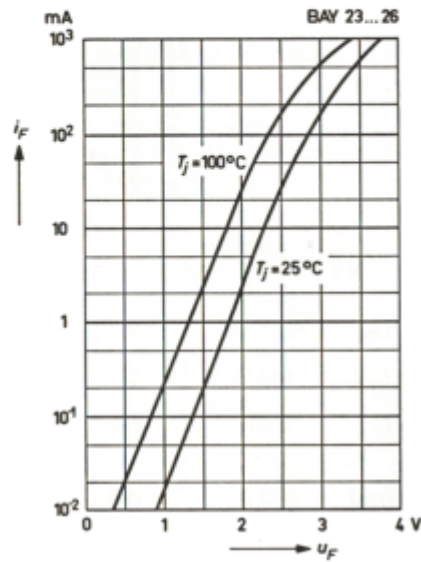
I_R <3 μ A

Wärmewiderstand
Sperrschicht - umgebende Luft

R_{thU} <0,42 K/mW

BAY 23 ... BAY 26

Durchlaßkennlinien
 $T_j = 25\text{ °C}$, $T_j = 100\text{ °C}$



zul. Durchlaß-Gleichstrom
in Abhängigkeit von der
Einschaltdauer,
ausgehend von $T_j = 25\text{ °C}$

